

	会期	2018年9月18日(火)～21日(金) Dates: September 18(Tue) - 21(Fri)
	場所	名古屋国際会議場 Venue: Nagoya Congress Center

## 講演情報

一般セッション(口頭講演)

13 半導体 13.3 絶縁膜技術

### [21a-145-1~9] 13.3 絶縁膜技術

2018年9月21日(金) 09:00 ~ 11:30 145 (レセプションホール)

中塚 理(名大)、石崎 博基(埼玉工大)

△：奨励賞エントリー

▲：英語発表

▼：奨励賞エントリーかつ英語発表

空欄：どちらもなし

09:30 ~ 09:45

### [21a-145-3] 高純度オゾン由来の活性種を用いた室温CVD-SiO<sub>2</sub>膜の特性

○亀田 直人<sup>1</sup>、三浦 敏徳<sup>1</sup>、森川 良樹<sup>1</sup>、花倉 満<sup>1</sup>、中村 健<sup>2</sup>、野中 秀彦<sup>2</sup>

(1.明電舎、2.産総研)

キーワード：オゾン酸化、CVD、SiO<sub>2</sub>膜

室温成膜技術は、有機ELディスプレイ等フレキシブルエレクトロニクス分野で用いられる耐熱性の低いフレキシブル基板上でのデバイス作製プロセスに必要である。今回、CVD成膜温度の低温化のため、高純度オゾンとエチレン (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) ガスの反応による大量のOHラジカル生成技術[をCVDに適用し、室温でのSiO<sub>2</sub>成膜を試みた。膜質について報告する。